

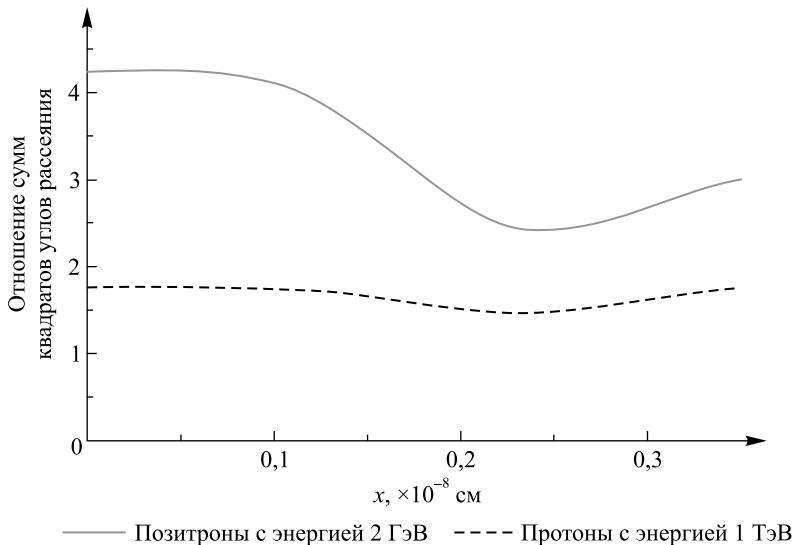


Рис. 3. Рассчитанные для позитронов с энергией 2 ГэВ и протонов с энергией 1 ТэВ

зависимости отношения суммы квадратов углов некогерентного рассеяния на электронах и ядрах,

вычисленной по формуле (23) для электронного рассеяния и в соответствии с работой [26]

для ядерного рассеяния, к аналогичной сумме, найденной по формуле (24) для электронного рассеяния

и в соответствии с работой [12] для ядерного рассеяния, от расстояния

до атомной плоскости (110) кристалла кремния

Fig. 3. The dependences of the ratio of the sum of squares of the angles of incoherent scattering by electrons

and nuclei calculated using the formula (23) for electron and in accordance with reference [26] for nuclear

scattering to the analogous sum calculated by the formula (24) for electron and in accordance with reference [12]

for nuclear scattering for the cases of positrons of energy 2 GeV and protons of energy 1 TeV

on the distance to the atomic plane (110) of the silicon crystal